

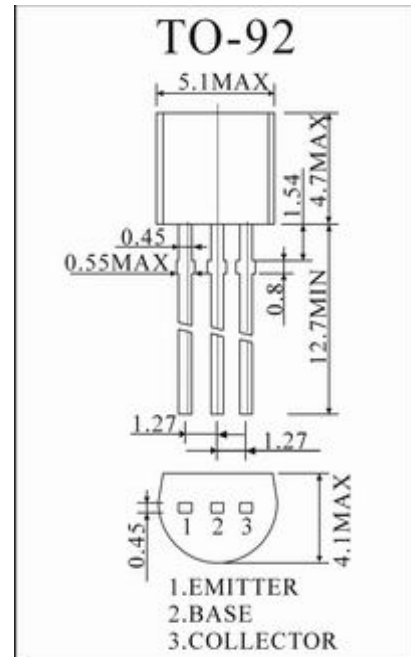
## 2N4401

—NPN silicon—

■■主要用途：开关、放大等。

■■绝对最大额定值 (Ta=25℃)

项 目	符 号	额 定 值	单 位
集电极—基极电压	V <sub>CB0</sub>	60	V
集电极—发射极电压	V <sub>CEO</sub>	40	V
发射极—基极电压	V <sub>EBO</sub>	6	V
集电极电流	I <sub>C</sub>	600	mA
集电极耗散功率	P <sub>C</sub>	600	mW
结 温	T <sub>J</sub>	150	℃
存储温度	T <sub>stg</sub>	- 55~150	℃



■■电参数 (Ta=25℃)

项 目	符 号	最 小 值	典 型 值	最 大 值	单 位	测 试 条 件
直流电流增益	h <sub>FE</sub>	100		300		V <sub>CE</sub> = 1V, I <sub>C</sub> = 150mA
集电极-基极截止电流	I <sub>CB0</sub>			0.1	μ A	V <sub>CB</sub> = 35V, I <sub>E</sub> =0
发射极-基极截止电流	I <sub>EBO</sub>			0.1	μ A	V <sub>EB</sub> = 5V, I <sub>C</sub> =0
集电极-基极击穿电压	BV <sub>CB0</sub>	60			V	I <sub>C</sub> = 0.1mA, I <sub>E</sub> =0
集电极-发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	40			V	I <sub>C</sub> = 1mA, I <sub>B</sub> =0
发射极-基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	6			V	I <sub>E</sub> = 0.1mA, I <sub>C</sub> =0
集电极-发射极饱和压降	V <sub>CE(sat)</sub>			0.5	V	I <sub>C</sub> = 500mA, I <sub>B</sub> = 50mA
基极-发射极饱和压降	V <sub>BE(sat)</sub>			1.2	V	I <sub>C</sub> = 500mA, I <sub>B</sub> = 50mA
电流增益-带宽乘积	f <sub>T</sub>	250			MHz	I <sub>C</sub> = 20mA, V <sub>CE</sub> =10V f=100MHz
开启时间	t <sub>on</sub>			35	ns	V <sub>CC</sub> = 30V, V <sub>BE</sub> =2V, I <sub>C</sub> =150mA, I <sub>B1</sub> = 15mA
关断时间	t <sub>off</sub>			255	ns	V <sub>CC</sub> = 30V, I <sub>C</sub> = 150mA, I <sub>B1</sub> = I <sub>B2</sub> = 15mA

■■h<sub>FE</sub> 分档及其标志

分档

h<sub>FE</sub>

100~300